

БОЛЬШЕ РИККАРДИК САНДВИЧ  
Микросхема 301НР1В



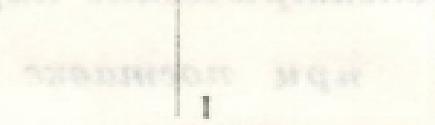
## ЭТИКЕТКА

Микросхема интегральная пленочная типа  
301НР1В. Основное назначение: декодирующая  
резистивная матрица типа В-2В.

### Схема расположения выводов

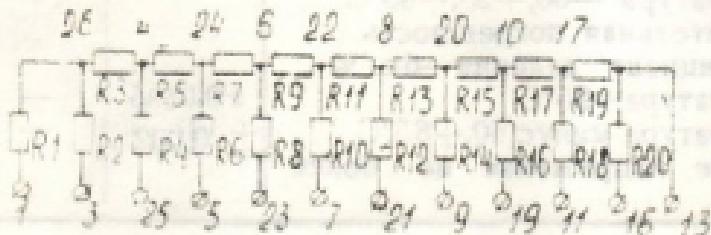
Обозначение

первого вывода



Отсчет выводов производить против часовой стрелки от обозначения первого вывода.

### Схема электрическая принципиальная



# Таблица назначения выводов

| Контакт | Цель<br>(сопротивление), кОм | Контакт | Цель [сопротивление] |
|---------|------------------------------|---------|----------------------|
|         |                              |         | кОм                  |
| 1       | 2                            | 1       | 2                    |
| 1-26    | R1=10                        | 22-8    | R11=5                |
| 3-26    | R2=10                        | 21-8    | R12=10               |
| 26-4    | R3=5                         | 8-20    | R13=5                |
| 25-4    | R4=10                        | 9-20    | R14=10               |
| 4-24    | R5=5                         | 20-10   | R15=5                |
| 5-24    | R6=10                        | 19-10   | R16=10               |
| 24-6    | R7=5                         | 10-17   | R17=5                |
| 23-6    | R8=10                        | 11-17   | R18=10               |
| 6-22    | R9=5                         | 17-13   | R19=5                |
| 7-22    | R10=10                       | 16-13   | R20=10               |

*Основные электрические параметры  
при поставке*

| Наземование параметра                       | Норма        |          |
|---|--------------|----------|
|   | не более     | не менее |
| 1   | 2            | 3        |
| Сопротивление резисторов, кОм               |              |          |
| 2В  | 11           | 9        |
| В   | 5,5          | 4,5      |
| Температура $-60, +25, +85^{\circ}\text{C}$ |              |          |
| Относительная погрешность                   |              |          |
| Коэффициент деления—бк, %                   |              |          |
| Температура $+25^{\circ}\text{C}$           | $\pm 0,0135$ | —        |
| Температура минус 60, $+85^{\circ}\text{C}$ | $\pm 0,032$  | —        |
| Входное напряжение не более 12,6 В          |              |          |

| Наименование параметра                           | Норма                 |          |
|--|-----------------------|----------|
|  | не более              | не менее |
| 1  | 2                     | 3        |
| Сопрот. изоляции—В из, МОм                       | —                     | 100      |
| Температура +25°C                                |                       |          |
| Испытательное напряжен. 100В                     |                       |          |
| Время установления переходных процессов—уст, МКС | 0,5                   | —        |
| Температура — 60, +25, +85°C                     |                       |          |
| Температурный коэффициент сопротивления—ТКС, °C  | +2,5.10 <sup>-4</sup> | —        |
| Температура — 60, +25, +85°C                     |                       |          |

*Пределные значения допустимых  
электрических режимов эксплуатации*

| Наименование параметра              | Тип (типоно-<br>минал)<br>микросх. | Норма      |            | Примечание |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                     |                                    | не<br>мен. | не<br>бол. |            |
| 1                                   | 2                                  | 3          | 4          | 5          |
| Рассеиваемая мощность<br>—Ррас, мВт | 30!НР1В                            | —          | 50         | —          |

# СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

|         |       |     |
|---------|-------|-----|
| ЗОЛОТО  | 1,227 | МГ. |
| СЕРЕБРО | 90,27 | МГ. |

## Указания по эксплуатации.

1. Выводы микросхем формонке не подлежат. В технически обоснованных случаях допускается удалять нерабочие выводы микросхем и излишки рабочих выводов после пайки любым способом, исключающим нарушение запрессовки вывода в основании корпуса и не приводящим к ухудшению электрических параметров микросхем.

2. Допускается 3-х кратный монтаж и демонтаж микросхем, при этом электрические параметры должны соответствовать нормам в ТУ.

3. Интервал между паяками соседних выводов не менее 10 с, жало паяльника должно быть заземлено.

4. Для повышения влагоустойчивости микросхемы должны быть покрыты после монтажа на платы тремя слоями лака Э-4160 или УР-231, температура сушки лака не должна превышать  $80^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$ .

Микросхема типа 301НР1В соответствует техническим условиям ОЖО. 345. 001 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

ФЕВ 1983

Штамп ОТК

Штамп представителя заказчика

Технические условия ОЖО. 345. 001 ТУ